

拒絶理由通知書

DS P 961'7 Issue Fee
清算(DS P 13320
DS P 15151)

特許出願の番号	特願 2000-108563
起案日	平成 15 年 10 月 20 日
特許庁審査官	和瀬田 芳正 2929 4R00
特許出願人代理人	志賀 正武 (外 6名) 様
適用条文	第 29 条第 2 項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から 60 日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第 29 条第 2 項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項 1 - 3, 5
- ・引用文献等 1
- ・備考

特に 3 頁右下欄 14 行 - 4 頁左下欄 4 行、第 1 図を参照。引用例 1 に記載の発明では、基板交換室 2 内の残留水分濃度が所要の水分分圧以下になるまでベークを行っているのであるから、水分濃度を計測し、基板の加熱時間を調整しているものと認められる。また、ベークを反応室内で行うように変更したことに格別の困難性は認められない。

- ・請求項 1, 4 - 5
- ・引用文献等 2
- ・備考

引用例 2 には反応ガスの水分を測定することで、薄膜の結晶性、膜質の均一性を保つことが記載されているのであるから、その具体的手段として「水分濃度に基づいて反応性ガス処理の条件を調整する」ことは当業者が容易に想到できたものである。また、引用例 2 に記載の発明を「表面の少なくとも一部に酸化シリコンが形成されている基板」に適用したことに格別の困難性は認められない。

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

引用文献等一覧

1. 特開平04-085927号公報 ← IDS済
2. 特開平10-144581号公報 ← 未IDS

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 IPC第7版 H01L 21/205, 21/302

・先行技術文献 特開昭60-145999号公報 } 未IDS
特開平06-061199号公報 }

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ、または面接のご希望がございましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第三部 金属加工(電子素材加工) 和瀬田芳正

TEL. 03(3581)1101 内線3470 FAX. 03(3580)6905

NOTICE OF REASONS FOR REJECTION

Application Number: 2000-108563
Drafting Date: 2003/10/20 (year/month/day)
Mailing Date: 2003/10/28 (year/month/day)
Attorney: Masatake SHIGA et al.
Applied Provision: Article 29, Paragraph 2

This application is rejected for the reasons lain forth below. If the applicant wishes to comment thereon, the applicant is invited to submit a response within 60 days from the mailing date of this notice.

REASON

The invention(s) according to the below-listed claim(s) of the present application could have been easily made prior to filing date by a person with average knowledge in the field to which the invention(s) belongs based on the invention(s) disclosed in the below-listed publication(s), distributed in Japan or abroad prior to the filing date of this application, and it is therefore deemed to be unpatentable in compliance with the provisions of Japanese Patent Law, Article 29, Paragraph 2.

NOTE (See List of Citations for Detail of the Citations)

·Claims: 1 to 3, 5

·Citations, etc.: 1

·Remarks

See line 14, in right-bottom section in page 3 to line 4, in left-bottom section in page 4, and FIG. 1, particularly. In an invention shown in a Citation 1, a baking operation is performed until a remaining moisture density in a base board changing chamber 2 is less than a predetermined moisture pressure. Therefore, it is understood that a moisture density is measured so as to adjust a heating time for the base board. Also, there is no particular difficulty in performing the baking in a reaction chamber.

·Claims: 1, 4 to 5

·Citations, etc.: 2

·Remarks

In the Citation 2, it is disclosed that a crystalline characteristics, and a uniformity of the substrate are maintained by measuring a moisture in a reaction gas. Therefore, it could have been anticipated easily by a person having an ordinary skill in the art to "adjust conditions for a reactive gas processing operation according to the measured moisuture." Also, there is not a particular difficulty in employing an invention disclosed in the Citation 2 for "a base board on a part of which surface a silicon oxide is formed".

Reasons for Rejection are not found to the Inventions according to the rest of the above-mentioned Claims at present. Reasons for Rejection are notified when new Reasons for Rejection are found.

LIST OF CITATIONS (See List of Citations for Detail of the Citations)

1. Japanese Unexamined Patent Application, First Publication No. Hei 04-085927
2. Japanese Unexamined Patent Application, First Publication No. Hei 10-144581

RECORD OF PRIOR ART SEARCH

·Searched Technical Fields: IPC 7th Version H01L 21/205, 21/302

·Prior Art Documents

Japanese Unexamined Patent Application, First Publication No. Sho 60-145999

Japanese Unexamined Patent Application, First Publication No. Hei 06-061999

The search records for these prior art documents do not constitute reasons for rejection.